

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA

G992 - Dispositivos y Circuitos Electrónicos

Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática

Curso Académico 2025-2026

1. DATOS IDENTIFICATIVOS					
Título/s	Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática			Tipología y Curso	Obligatoria. Curso 2
Centro	Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación				
Módulo / materia	MATERIA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA MÓDULO COMÚN A LA RAMA INDUSTRIAL				
Código y denominación	G992 - Dispositivos y Circuitos Electrónicos				
Créditos ECTS	6	Cuatrimestre	Cuatrimestral (2)		
Ámbito de conocimiento	Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación				
Web					
Idioma de impartición	Español	English friendly	Sí	Forma de impartición	Presencial

Departamento	DPTO. TECNOLOGIA ELECTRONICA E INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA				
Profesor responsable	FRANCISCO JAVIER AZCONDO SANCHEZ				
E-mail	javier.azcondo@unican.es				
Número despacho	E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación. Planta: - 3. DESPACHO PROFESORES (S3019)				
Otros profesores	JUAN ECHEVARRIA CUENCA FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ				

4. OBJETIVOS	
-	Entender el comportamiento característico de diodos, MOSFETs y BJT.
-	Entender cómo diseñar y analizar amplificadores monoetapa utilizando MOSFETs y BJT.
-	Entender la operación de un dispositivo interruptor en etapas de conversión de potencia
-	Entender cómo diseñar y analizar circuitos digitales simples utilizando MOSFETs

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE	
CONTENIDOS	
1	<p>Bloque temático 1. Circuitos con diodos.</p> <p>1.1. Fundamentos de los diodos y dispositivos optoelectrónicos. Semiconductores (Bandas de energía, electrones y hueco; Semiconductores intrínsecos y dopados; Generación y recombinación de portadores; Mecanismos de conducción. Difusión y deriva). Unión p-n (Estructura; Polarización en inversa y polarización en directa; Característica I-V; Efectos de temperatura; Zona de bajo dopado en dispositivos potencia. Modulación de la conductividad). Otros tipos de diodos (Varactor, Schottky, Fotodiodo, LED y Célula solar).</p> <p>1.2. Modelos de los diodos. Característica I-V de la unión p-n (Diodo ideal; Modelo de caída de tensión constante; Modelo de fuente de tensión + resistencia). Modelo en pequeña señal. Modelo del diodo Zener. Modelo SPICE del diodo.</p> <p>1.3. Aplicaciones de los diodos. Cargador de batería (Rectificadores de media onda, de onda completa y en puente; Detector de pico; Estabilizador de tensión. Efecto de la carga en la tensión de salida). Demodulador (Detector de pico). Limitador de tensión (Circuitos limitadores y fijadores de nivel). Conformador de señal (Funciones de transferencia lineales a tramos). Análisis de circuitos con diodos utilizando SPICE</p>
2	<p>Bloque temático 2. Circuitos con transistores MOS.</p> <p>2.1. Dispositivos MOS. Estructura del transistor MOS. Características corriente – tensión (I/V) (Operación en la zona lineal o triodo; Operación en la zona de saturación). Capacidades del MOS. Modelo de gran señal. Modelo de pequeña señal. Transistores PMOS. Modelo SPICE.</p> <p>2.2. Transistor MOS en continua. Polarización del MOS (Divisor de resistencias; Autopolarización). Diseño con tecnología de circuitos integrados (Inversores NMOS; Carga de enriquecimiento; Carga de empobrecimiento; Fuente de corriente). Espejos de corriente (Espejo de corriente cascode).</p> <p>2.3. Transistor MOS en circuitos digitales. Características estáticas de un inversor digital (Inversores NMOS; Inversor CMOS; Función de transferencia en tensión; Corriente de alimentación). Llaves MOS. Características dinámicas de un inversor digital (Tiempo de propagación; Disipación de potencia). Puertas lógicas NMOS y CMOS.</p> <p>2.4. Amplificadores monoetapa y multietapa MOS. Concepto de amplificación (Ganancia en tensión, resistencia de entrada y salida). Modelo en pequeña señal. Amplificador MOS de una etapa discreto. Técnicas de cargas activas. Configuraciones en fuente común, drenador común y puerta común. Amplificador cascode. Acoplo de varios transistores. Amplificadores de varias etapas. Ejemplos de simulación en SPICE.</p> <p>2.5. El amplificador diferencial MOS. El par diferencial MOS. Operación de gran señal. Operación de pequeña señal del par diferencial MOS (Ganancia en modo común; Ganancia en modo diferencial; CMRR). Características no ideales del amplificador diferencial. Amplificador diferencial con cargas activas (Conversión señal diferencial a una salida).</p> <p>2.6. Fabricación de los circuitos integrados MOS. Introducción. Pasos de fabricación de un circuito integrado. Procesos VLSI para obtener dispositivos integrados (MOSFET; Resistencias; Condensadores; Inductancias; Diodos; Transistores bipolares). Diseño de máscaras y Layout de un circuito integrado CMOS. Reglas de escalado de los dispositivos integrados.</p>
3	<p>Bloque temático 3. Circuitos con transistores bipolares.</p> <p>3.1. Circuitos con transistores BJT. Estructura del dispositivo y operación del BJT. Curvas características corriente-tensión (Modos de operación). Modelo de pequeña señal. Comparación de las prestaciones del transistor bipolar y del transistor MOS. Circuitos de polarización del BJT (Red de resistencias; Espejos de corriente). Amplificadores con transistores bipolares (Amplificadores de una etapa; Interconexiones de transistores; Amplificador diferencial)</p>
4	<p>Bloque temático 4 Circuitos con dispositivos de potencia.</p> <p>4.1. Dispositivos de potencia (El conmutador de potencia ideal; Diodos de potencia; MOSFET de potencia; IGBT).</p>

7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE				
Descripción	Tipología	Eval. Final	Recuper.	%
Evaluación de laboratorio	Evaluación en laboratorio	Sí	Sí	30,00
Examen bloque 1	Examen escrito	Sí	Sí	30,00
Seguimiento	Otros	Sí	Sí	10,00
Examen bloque 2	Examen escrito	Sí	Sí	30,00
TOTAL				100,00
Observaciones				
<p>Se requiere puntualidad en la asistencia a la las clases para poder participar en las pruebas de seguimiento, integradas en la actividad docente.</p> <p>En el caso de que los criterios sanitarios lo hagan necesario, las pruebas de evaluación se realizarán siguiendo el formato de docencia mixta, presencial en aula y fuera de ella. En el caso más extremo de que se imposibilite o sea inconveniente la asistencia de todos los alumnos y profesores al centro, las pruebas de evaluación se desarrollaran utilizando medios telemáticos. En estos casos, el contenido de las pruebas, siendo semejante al caso presencial se podrá particularizar total o parcialmente para cada estudiante y utilizar técnicas permitidas necesarias para garantizar la validez de las pruebas que pueden modificar las condiciones y tiempo de realización de las mismas.</p> <p>Se prevé la evaluación a distancia de estos mismos trabajos, ejercicios prácticos de laboratorio y pruebas escritas, en el caso de una nueva alerta sanitaria por COVID-19 haga imposible realizar la evaluación de forma presencial.</p>				
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial				
<p>Los alumnos a tiempo parcial con incompatibilidad de horario pueden ser evaluados mediante las pruebas del bloque 1 y 2 y reciben una atención personal directa o por medios telemáticos sobre los contenidos.</p>				

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS
BÁSICA
Sedra/Smith Microelectronic Circuits (6th edition). Oxford University Press. 2010
Behzad Razavi. Fundamentals of Microelectronics. 2nd Edition Wiley. 2013

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la Guía Docente Completa.